

OPC H-TECプロセスNEX

Electroless Copper Plating Process for Horizontal Conveyance System

OPC H-TEC PROCESS NEX

- ▶ 内層銅箔/めっき皮膜間の接続信頼性に優れる
- ▶ 搬送跡やプリディップ液の持ち込みによるパラジウム異物不良を削減できる
- ▶ キャタリスト浴のパラジウム濃度を従来プロセスの約50%に低減

- Excellent in connecting reliability between inner copper foil and plating film
- Can reduce marks by rollers, prevent defects by Pd impurities
- Can reduce Pd concentration in catalyst bath to approx. 50% (Compared with conventional bath)

処理工程 Process



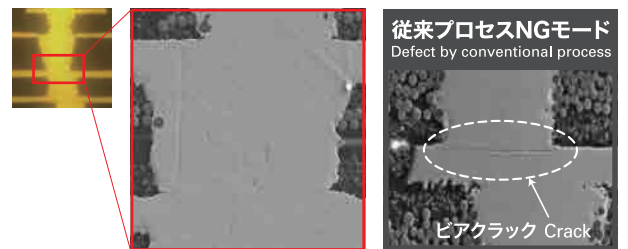
優れた接続信頼性

Excellent in connecting reliability

PCT後にヒアクラックおよび抵抗値の変化なし

No crack, No change in electrical resistance

■PCT (Pressure Cooker Test)



PCT条件: 0.2MPa, 温度121°C, 湿度 100%, 12時間
Condition: 0.2MPa, temperature 121°C, 100% RH, 12h

銅上に対する低いパラジウム吸着量

Reduce Pd adsorption amount adhering on Cu

		OPC H-TECプロセス NEX パラジウム 100 mg/L OPC H-TEC PROCESS NEX Pd 100 mg/L	従来プロセス パラジウム 210 mg/L Conventional process Pd 210 mg/L
基材 Substrate	樹脂 Resin	0.082	0.056
	銅 Copper	0.0036	0.0047

単位: (mg/dm²)

異物不良の原因となるキャタリスト凝集物が発生しない

Prevent catalyst aggregation, reduce defects by impurities

